

# GaN 研究コンソーシアム スプリングスクール開催ご案内

2019年2月

GaN 研究コンソーシアム事務局

GaN 研究コンソーシアムは、産学官の共創場での実践的教育を通して、高い専門性と俯瞰的な視点を兼備し、社会のための科学 (Science for Society) を志向する、21 世紀型の若手研究者・技術者の育成に努めることにしています。これを踏まえて、我が国の GaN 研究開発の将来を担う優秀な人材を育成するため、昨年に引き続きスプリングスクールを開講します。本年は基礎的知識の修得を目的とした講義とパワーデバイス・システム領域の基礎研究から実用化開発を意図したプログラムといたします。

◆開催日 2019年3月26日(火)・27日(水)

◆場 所 名古屋大学(東山キャンパス) ES 総合館1階 ES 会議室

<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>

◆対象者 GaN 研究コンソーシアムの会員である機関に所属する大学院生、ポストドクター研究員、社会人

※会員ではない機関からの参加希望があった場合、会員機関の参加を優先いたします。

◆募集人数 50名

◆募集期間 2019年2月4日(月)～3月14日(木)

※応募者が定員に達した場合、募集を締め切ります。

◆参加費

《GaN 研究コンソーシアムの会員機関》

各機関2名まで無料。それを超える場合は、一人1万円。

※大学院生は参加費無料、交通費・宿泊費を補助します(最大3万円)

《GaN 研究コンソーシアムの会員ではない機関》

一人5万円

◆プログラム 【別紙1】を参照ください。

スクール長 天野 浩 名古屋大学 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授・センター長

※調整中の講師は決定次第案内いたします。

※1日目の夕方に交流会を開催します。※参加費(別途)

◆参加申し込み方法

下記スクール事務局に、電子メールでご連絡ください。

申し込みの際は、①参加者氏名 ②所属機関 ③職業(学生または役職) ④年齢 ⑤連絡先(電話番号とメールアドレス) ⑥交流会参加の可否 を明記ください。

集合場所・時間等の詳細は参加登録後にメールでご連絡します。

個人情報を本スクール参加登録以外の目的で使用する事、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】 GaN 研究コンソーシアム/スプリングスクール事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp (電話 052-747-6584 )

【事務局メンバー】 名古屋大学

研究協力部社会連携課：杉山 典史、相田 暁彦

学術研究・産学連携推進本部 企画戦略グループ：佐藤 浩哉、笹岡 千秋、水野 紘一、山口 淳

## GaN 研究コンソーシアム スプリングスクール プログラム

【第一日目】 3月26日(火) GaN 基礎、パワーデバイス基礎および応用技術

(氏名は敬称略)

時 間	内 容	講 師
9:00~9:05	スクール長 挨拶	天野 浩 (名大)
9:05~9:10	オリエンテーション (趣旨、スケジュール)	事務局
9:10~10:30	GaN 概論 (材料物性・電子物性評価)	須田 淳 (名大)
10:30~12:00	パワーデバイス基礎	加地 徹 (名大)
昼 食 (各 自)		
13:00~14:30	パワーエレクトロニクスロードマップ #1	岩室 憲幸 (筑波大)
14:30~14:40	(ブレイク)	
14:40~16:10	パワーデバイスモジュール (実装技術) #2	梅谷 和弘 (岡山大学)
16:10~17:40	パワーエレクトロニクス熱設計・信頼性 #3	神谷 有弘 (デンソー)
17:40~19:00	交流会	

第一日目 (午後) 講演プログラムの狙い

# 1 パワーエレクトロニクスの動向と GaN パワーデバイスの位置づけ、GaN パワー応用が広く市場に普及するためのポイント

# 2 パワーモジュール/実装技術

# 3 車載アプリケーションにおけるポイント、熱設計、信頼性評価、GaN パワーデバイスを車載応用する上での課題

【第二日目】 3月27日(水) パワーエレクトロニクス回路、光デバイス、高周波回路

時 間	内 容	講 師
9:00~10:30	パワーエレクトロニクス回路基礎	今岡 淳 (名大)
10:30~12:00	パワーエレクトロニクス応用	山本 真義 (名大)
昼 食 (各 自)		
13:00~14:30	光デバイス基礎	竹内 哲也 (名城大)
14:30~16:00	高周波回路基礎	原 信二 (名大)
16:00~16:30	修了式	